

特点

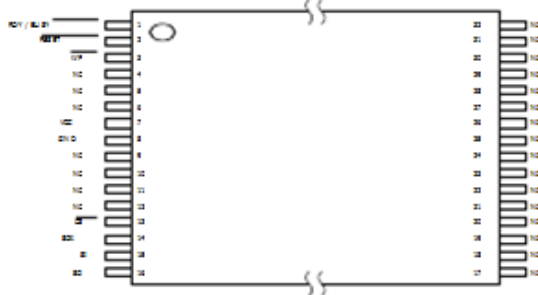
- 单2.7V - 3.6V电源
- 串行接口架构
- 页编程操作
 - 单周期重新编程（擦除和编程）
 - 1024页（264字节/页）主内存
- 两个264字节的SRAM数据缓冲区 - 允许接收数据而非易失性存储器的重新编程
- 内部的计划和控制的定时器
- 快速页编程时间 - 7毫秒典型
- 120 μ s典型的页面，以缓冲传输时间
- 低功耗
 - 4毫安有效的读电流典型
 - 5 μ 安一种CMOS待机电流典型
- 5 MHz的最大时钟频率
- 硬件数据保护功能
- 串行外设接口（SPI）兼容 - 模式0和3
- CMOS和TTL兼容输入和输出
- 商用和工业温度范围

描述

该AT45DB021是一个只有2.7伏，串行接口闪存适合于-系TEM重新编程。其2162688位存储器组织为1024页264字节每个。除了在主存储器中，AT45DB021还包含两个每264字节的SRAM数据缓冲区。该缓冲器允许接收而数据在主存储器页面进行重新编程。不同于传统的闪存memo-被访问随机与多个地址线和并行接口里斯，该数据闪存采用串行接口以顺序存取其数据。简单的串行接口方便了硬件的布局，提高了系统的可靠性，减少了切换

引脚名称	功能
CS	芯片选择
SCK	串行时钟
SI	串行输入
SO	串行输出
WP	硬件页写保护引脚
RESET	芯片复位
RDY/ BUSY	就绪/忙

TSOP顶视图
类型1

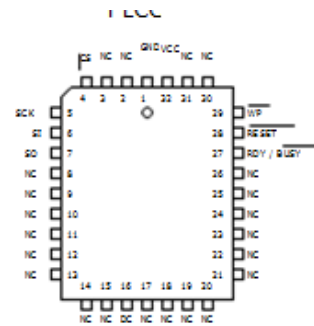


2-Megabit

2.7伏只

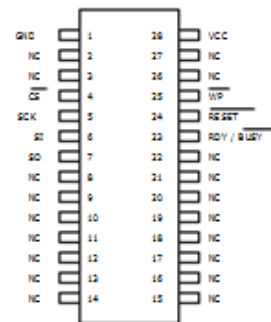
串行
数据闪存[®]

AT45DB021



注：PLCC封装引脚16和17请勿连接。

SOIC



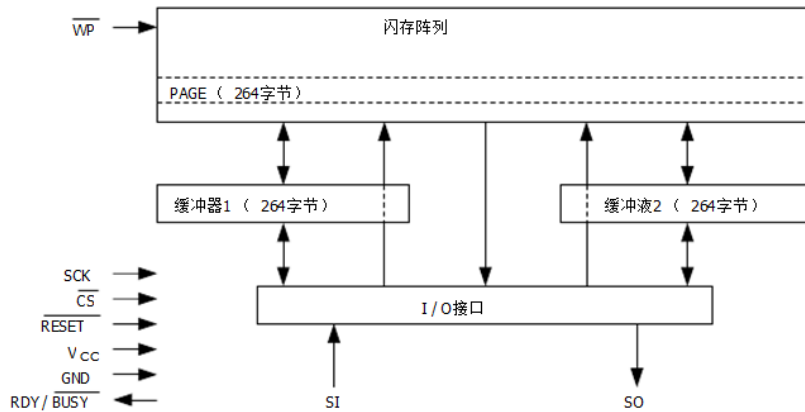
噪音，并降低了封装尺寸和积极的引脚数。该装置被用在许多商业和工业优化试验应用高密度，低引脚数，低电压和低功耗是必不可少的。典型应用对于数据闪存的数字化语音存储，图像存储，和数据的存储。该器件工作的时钟频率高达5兆赫与典型有效的读电流消耗为4 mA。

为了让简单的系统内可重编程中，AT45DB021不要求高输入电压为亲

编程。该器件采用单电源工作支持 PLY，2.7V至3.6V，福尔波个T他的公关OGR是一个可怕操作。该AT45DB021通过芯片使能通过三线接口选择引脚（CS）和访问由串行输入（SI）中，串行输出（SO）和串行时钟（SCK）。

所有的编程周期是自定义的，并没有单独的编程前擦除周期。

框图



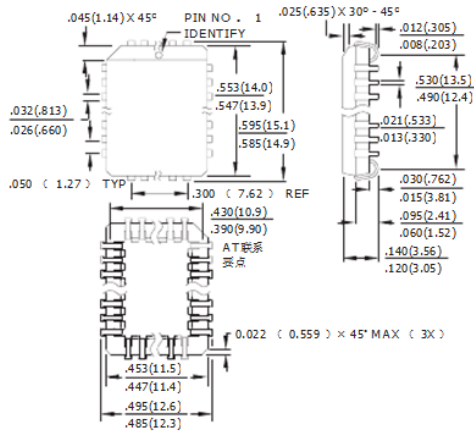
绝对最大额定值*

高温下偏置.....	-55 °C至+ 125°C
存储温度.....	-65 °C至+ 150°C
所有输入电压 (包括NC引脚)	
相对于地面.....	- 0.6V至+ 6.25V
所有输出电压	
相对于地面.....	- 0.6V至V _{CC} + 0.6V

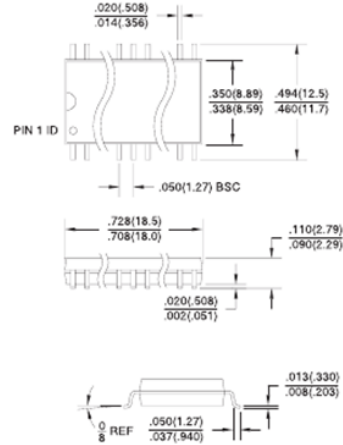
*注意：
强调超越“绝对上市最大额定值”，可能会造成永久性损坏年龄到设备。这是一个值仅为该器件在这些或任何功能操作超出所指示的其他条件本规范的业务部门所不暗示。暴露在绝对最大额定值长时间会影响器件的条件可靠性。

包装信息

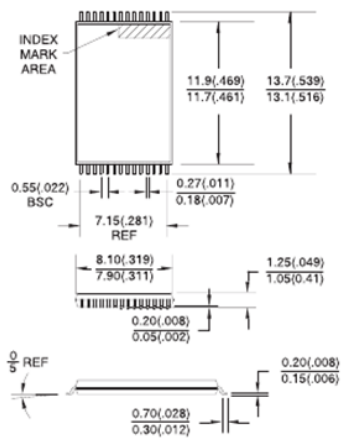
32J, 32脚, 塑料的J-引线芯片载体封装 (PLCC)
 尺寸以英寸 (毫米)
 JEDEC标准的MS-016 AE



28R, 28引脚, 宽0.330", 塑料鸥翼小外形封装 (SOIC)
 尺寸以英寸 (毫米)



28T, 28引脚塑料薄型小尺寸封装 (TSOP)
 尺寸以毫米 (英寸) *



*控制尺寸: 毫米